

2SB529

低周波電力増幅用
シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形

概 要

2SB529は、シリコン樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャルプレーナ形パワートランジスタで、コレクタ損失は5W(100×100×2mmアルミニウム放熱板つき、周囲温度25℃)、コレクタ電流は-2Aです。大電流での直流電流増幅率の低下が非常に少ないので、低歪率の出力が得られ、カーステレオ等の出力用として、2SD359とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

特 長

- 大電流での h_{FE} の低下が非常に少ない
- コレクタ電流が大きい($I_C = -2A$ 、 $I_{CM} = -3A$)
- Knee特性が良い($V_{CE} \leq -1V$)

用 途

- カーステレオ、カーラジオ、テープレコーダ等の3～10W出力の低周波電力増幅回路

最大定格($T_C = 25^\circ C$)

記 号	項 目		定 格 値	単 位
V _{CB0}	コレクタ・ベース間電圧		－40	V
V _{EB0}	エミッタ・ベース間電圧		－5	V
V _{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧		－20	V
I _C	コレクタ電流		－2	A
I _{CM}	せん頭コレクタ電流		－3	A
P _C	コレクタ損失	T _a ＝25℃	1	W
P _C		T _C ＝25℃	10	W
T _J	接合部温度		150	℃
T _{stg}	保存温度		－55 ～ ＋150	℃

電氣的特性($T_C = 25^\circ C$)

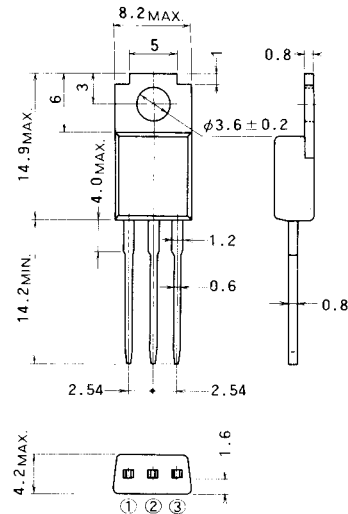
記 号	項 目	測 定 条 件	特 性 値			単 位
			最 小	標 準	最 大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -1mA$, $I_E = 0$	-40			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -1mA$, $I_C = 0$	-5			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -10mA$, $R_{BE} = \infty$	-20			V
I_{CB0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB} = -25V$, $I_E = 0$			-1	μA
I_{EB0}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB} = -5V$, $I_C = 0$			-1	μA
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4V$, $I_C = -0.5A$, パルス測定	55	110	300	
V_{CE}	コレクタ・エミッタ間電圧	$I_C = -1.5A$, $I_B = -0.05A$			-1	V
V_{BE}	ベース・エミッタ間電圧	$V_{CE} = -4V$, $I_B = -0.05A$		-0.7		V

†: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
h_{FE}	55 ~ 110	90 ~ 180	150 ~ 300

外形図

単位: mm



電極接続

- ①: ベース EIAJ: -
②: コレクタ(放熱板) JEDEC: -
③: エミッタ

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。